

изготовление и установку мемориальной доски внутри здания Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН (г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4) со следующим текстом: "В этом Институте с 1958 года по 2002 год работал выдающийся учёный академик Александр Михайлович Панченко".

- Разрешить Уфимскому научному центру РАН израсходовать за счёт своих средств до

10 тыс. руб. на проектирование, изготовление и установку мемориальной доски на доме, где проживал член-корреспондент РАН Р.Г. Кузеев (г. Уфа, ул. Менделеева, д. 148/3) со следующим текстом: "В этом доме с 1995 года по 2005 год жил видный учёный и общественный деятель, член-корреспондент РАН, действительный член Академии наук Республики Башкортостан, почётный гражданин города Уфы Раиль Гумерович Кузеев".

ЮБИЛЕИ

АКАДЕМИКУ А.Л. АСЕЕВУ - 60 ЛЕТ



Александр Леонидович АСЕЕВ - известный учёный в области физики полупроводников, автор 195 научных публикаций, в том числе 2 монографий. Им выполнены исследования атомной структуры и электронных свойств полупроводниковых систем пониженной размерности; развиты технологии полупроводниковой микро-, опто- и наноэлектроники.

Учёным и его сотрудниками изучены атомные механизмы процессов кластеризации собственных точечных дефектов в кремнии и германии, а также свойства монокристаллических ступеней на поверхности кремния.

Под руководством и при непосредственном участии А.Л. Асеева для создания нового поколения инфракрасных фотоприёмных устройств разработана технология получения фоточувствительных слоев кадмий-ртуть-теллур методом молекулярно-лучевой эпитаксии и технология формирования полупроводниковых структур с квантовыми ямами, использующихся Институтом физики полупроводников СО РАН и промышленными предприятиями при изготовлении матричных и линейчатых фотоприёмных устройств, применяемых для решения задач, связанных с обороной страны.

Александр Леонидович принимает активное участие в разработке нанотранзисторов на основе структур кремний-на-изоляторе, новых типов элементов памяти и элементов силовой электроники.

Под руководством А.Л. Асеева создан современный научно-технологический комплекс для получения и исследования полупроводниковых микро- и наноструктур, изучения квантовых эффектов в них и создания нового поколения устройств полупроводниковой электроники, инфракрасной и СВЧ-техники; в Институте физики полупроводников СО РАН совместно с другими институтами СО РАН ведутся работы по получению кремниевых материалов для солнечной энергетики.

А.Л. Асеев - директор Института физики полупроводников СО РАН, заместитель председателя Объединённого учёного совета СО РАН по физико-техническим наукам, член Президиума СО РАН, член ряда научных советов РАН, редколлегий нескольких отечественных и зарубежных научных журналов, профессор филиала кафедры физики полупроводников Томского государственного университета. Среди его учеников 3 доктора и 5 кандидатов наук.

А.Л. Асеев награждён серебряной медалью "В благодарность за вклад в развитие Томского государственного университета".